МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель Ученого совета факультета радиотехники и эле́ктроники

проф. Небольсин В.А.

(подпись) 2016 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Расчетно-конструкторская практика

(наименование дисциплины по учебному плану ООП)

для направления подготовки: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (код. наименование)

Профиль подготовки: Микроэлектроника и твердотельная электроника (название профиля, магистерской программы, специализации по УП)

Форма обучения очная

Срок обучения нормативный

Кафедра полупроводниковой электроники и наноэлектроники

(наименование кафедры-разработчика УМКД)

УМКД разработал: Арсентьев А.В., к.т.н.

(Ф.И.О., ученая степень авторов разработки)

Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии ФРТЭ

Протокол № 5 от «21 » 21. 2016 г.

Председатель методической комиссии _

(D N D)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Ученого совета

факультета радиотехники и электроники

проф. Небольсин В.А

(подпись) 2016 г.

учебно-методический комплекс дисциплины

Расчетно-конструкторская практика

(наименование дисциплины по учебному плану ООП)

для направления подготовки: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

(код, наименование)

Профиль подготовки: Микроэлектроника и твердотельная электроника

(название профиля, магистерской программы, специализации по УП)

Часов по УП: 162; Часов по РПД: 162;

Часов по УП (без учета часов на экзамены): 162 Часов по РПД: 162;

Часов на самостоятельную работу по УП: 117 (72%);

Часов на самостоятельную работу по РПД: 117 (72%)

Общая трудоемкость в ЗЕТ: 4,5;

Виды контроля в семестрах (на курсах): 9кзамены -0; 3ачеты -0; 3ачеты с оценкой -6;

Курсовые проекты -0; Курсовые работы -0.

Форма обучения: очная;

Срок обучения: нормативный.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид заня-	№ семестров, число учебных недель в семестрах																	
тий	1/18		2 / 18		3 / 18		4 / 18		5 / 18		6/18		7 / 18		8 / 10		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД
Лекции											12	12					12	12
Лабораторные											-	-					-	-
Практические											33	33					33	33
Ауд. Занятия											45	45					45	45
Сам. Работа											117	117					117	117
Итого											162	162					162	162

Сведения о ФГОС, в соответствии с которым разработана рабочая программа дисциплины (модуля) — 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника». Утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 218.

Рецензент(ы):	Кова	ленко П.І	О., к.т.н.,	зам. І	гл. инже	енера АО «В
Рабочая программа готовки бакалавров ка", профиль "Микр	в по направ	влению 1	1.03.04 '	'Элек	троник	а и наноэл
Рабочая программа троники и наноэлек		на заседа	ании каф	едры	полупр	ооводников
протокол № 9 оз	16.0	1 2	2016 г.			
		-				n annémett
Зав. кафедрой ППЭ	H3	neref	= 0.0000000	С.И.	Рембез	a
		0 - acro				
		.0 - arro				
геты — 0; Зачеты с опенко сфіреграм		ora - 0.				
юты — В: Зачеты с опенко сфистрам		4				
юты — О: Зачеты с опсико с фуступам		4				
жицтээр « акела Мицтээр фа		olek weser.				
Mangraphes a Anene		PACON MACON				
Angrasios a acers Si \ S		PACON MACON				
Angrasios a acers Si \ S		PACON MACON				
0.01001Pn38 0.01001Pn38 0.18		PACON MACON				
CONTRACT CONTRA		PACON MACON				
0.0100170.08 0.18 9.18 8/10 0.18 9.18 8/10 0.18 9.18 8/10 0.18 9.18 8/10 0.18 9.18 8/10 0.18 9.18 8/10 0.18 9.18 9.18 0.18 9.18 9.18 0.18 9.18 9.18 0.18 9.18 9.18 0.18 9.18 9.18 0.18 9.18 9.18 0.18 9.18 9.18 9.18 9.18 0.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9		PACON MACON				

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ

Выписка из Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»:

«Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели, задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающим необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями итогового отчета и отзыва руководителя от предприятия. По итогам практики выставляется оценка. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка».

1. ЦЕЛИ РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ

1.1	Целью практики является формирование системы знаний по автоматизированному проектированию БИС с использованием САПР CadenceOrCAD16.5 и САПР TannerEDA 12
1.2	Для достижения цели ставятся задачи:
1.2.1	освоение студентами процесса схемотехнического проектирования КМОП-схем с использованием САПР CadenceOrCAD;
1.2.2	освоение студентами процесса функционального моделирования КМОП-схем с использованием CadenceOrCADPSpice;
1.2.3	освоение студентами процесса проектирования топологии комбинационных и последовательностных КМОП-схем в САПР TannerEDA.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Цикл ((раздел) ООП: Б2	код дисциплины в УП: Б2.П.2					
2.1 Требован	2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося						
Для успешного прохождения расчетно-конструкторской практики студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам							
Б1.Б.9	Информационные технологии						
Б1.Б.11	Теоретические основы электротехники						
Б1.Б.18	Основы проектирования элек	тронной компонентной базы					
Б1.Б.20	Схемотехника						
	2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее						
Б1.В.ОД.19	Б1.В.ОД.19 Проектирование БИС						
Б1.В.ДВ.8.1	Проектирование микропроце	ссорных устройств					

E1 D HD 0 1	1 , 5 , 5	
Ы.В.ДВ.9.1	Проектирование цифровых устройств в базисе ПЛИС	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ

ОПК-6	способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
	различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
	пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
	способностью владеть современными методами расчета и проектирования микро-
ПКВ-1	электронных приборов и устройств твердотельной электроники, способностью к
	восприятию, разработке и критической оценке новых способов их проектирования
ПКВ-4	способностью разрабатывать модели исследуемых процессов, материалов, элемен-
11IXD-4	тов, приборов, устройств твердотельной электроники и микроэлектронной техники

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

3.1	Знать:
3.1.1	общие сведения о функциональных узлах комбинационного типа, по- следовательностного типа, о схемотехнической реализации функциональных узлов по конструктивно-технологическим проектным нормам масштабируемой КМОП- технологии (ОПК-6);
3.2	Уметь:
3.2.1	проектировать функциональные схемы и топологии комбинационных и последовательностных КМОП-схем (ПКВ-4);
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками работы со схемотехническим редакторами CadenceOrCADCapture, Tanner Sedit, с симулятором OrCADPSpiceA/D, с редактором топологии Tanner L-Edit (ПКВ-1; ПКВ-4).

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ

Практика включает теоретические занятия, получение практических навыков работы в САПР CadenceOrCAD и TannerEDA, выполнение расчетно-конструкторской части практики по индивидуальному заданию.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ

Практика проводится на кафедре полупроводниковой электроники и наноэлектроники (ППЭНЭ) ВГТУ. Время проведения практики – 43,44 и 45 недели 3 курса (3 недели).

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАК-ТИКИ

Общая трудоемкость расчетно-конструкторской практики составляет 4,5 зачетные единицы, 162 часа.

No	Разделы (этапы) практики	Виды рабо стоятельну	Всего	Формы текуще-		
п/п	, , , , ,	лекции	практика	самостоят. работа	часов	го кон- троля
1	Функциональное моделирование КМОП-схем с использованием CadenceOrCADPSpiceA/D	4	11	39	54	отчет
2	Схемотехническое проектирование последовательностных КМОП-схем в САПР	4	11	39	54	отчет
3	Проектирование топологии комбинационных и последовательностных КМОП-схем в САПР LEditTannerEDA.	4	11	39	54	отчет, зачет
	Итого	12	33	117	162	

План-график проведения расчетно-конструкторской практики

№ недели	№ п/п	Виды работ студентов организационных мероприятий	Аудиторных занятий час.
	1	Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи практики. Маршрут проектирования ИС. (лекция). Работа с литературой.	3
	2	Знакомство с содержанием и правилами оформления отчета по практике. САПР топологии ИС. (лекция). Работа над отчетом.	3
1	3	Функционально-логическое проектирование ИС (лекция). Работа над отчетом. Конструкторскотехнологические требования масштабируемой КМОПтехнологии (практическая работа).	3
	4	Схемотехническое проектирование ИС (лекция). Работа над отчетом.	3
	5	Функциональная верификация ИС (лекция). Работа над отчетом.	3
	6	Базовые логические элементы КМОП ИС. (лекция). Работа над отчетом.	3
	7	Базовые логические элементы ТТЛ ИС (лекция). Работа над отчетом.	3
2	8	Базовые элементы памяти ИС. (лекция). Работа над отчетом. Основные элементы конструкции топологии заказных БИС по КМОП-технологии с двумя слоями металлизации (практическая работа).	3
	9	Специализированных (заказные/полузаказные) БИС	3

		конкретного применения (ASIC) (лекция). Работа над	
		отчетом.	
	10	Классификация ПЛИС (FPGA и CPLD) (лекция). Работа	3
	10	над отчетом.	J
	11	Понятие идеологии "система на кристалле" (System on	3
	11	chip, SOC) (лекция). Работа над отчетом.	J
	12	Архитектуры ПЛИС CPLD и FPGA компании Xilinx	3
	12	(лекция). Работа над отчетом.	J
	13	Архитектуры MAX и FLEX компании Altera (лекция).	
3		Топологические особенности построения D-триггеров с	3
		двумя слоями металлизации (практическая работа). Ра-	3
		бота над отчетом.	
	14	Архитектуры ПЛИС фирмы Actel (лекция). Проверка	3
	14	отчетов.	J
	15	Подготовка к зачету и сдача зачета по практике	3
ИТО	ГО:		45

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ

	В рамках прохождения расчетно-конструкторской практики предусмотрены					
	следующие образовательные технологии:					
8.1	Лекции: информационные лекции, лекции – визуализации, проблемные лекции,					
	лекции с разбором конкретной ситуации					
8.3	Практическая работа (ознакомление с оборудованием, приборами, проведение					
	эксперимента, измерений, выполнение расчетов):					
	 выполнение индивидуального задания, 					
	- оформление и защита отчета;					
8.4	Самостоятельная работа студентов:					
	 изучение теоретического материала, 					
	 наработка навыков проектирования в САПРе, 					
	 работа с учебно-методической литературой, 					
	 составление и оформление отчета, 					
	- подготовка к зачету					
8.4	Консультации по всем вопросам расчетно-конструкторской практики.					

Индивидуальное задание включает теоретический вопрос по одному из классов ИС, технологии или архитектуре ИС, практическое задание по схемотехническому и топологическому проектированию последовательностного устройства. Задание выдается в виде электрической принципиальной схемы по вариантам.

 $\Phi OPMЫ$ ATTECTAЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) - дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ

		9.1.1. Основная литература		
№	Авторы,	Заглавие	Годы изда-	Обес-
Π/Π	составители		ния. Вид	печен-
			издания	ность
9.1.1.1	Строгонов А.В.	Проектирование устройств цифровой	2013	1
	_	обработки сигналов для реализации в	Маг. носит.	
		базисе программируемых логических		
		интегральных схем: учебное пособие.		
		Воронеж: ВГТУ		
9.1.1.2	Строгонов А.В	Цифровая обработка сигналов в базисе	2015	1
		грограммируемых логических инте-	Маг. носит.	
		ральных схем: учебное пособие. Воро-		
		неж: ВГТУ		
9.1.1.3	Бордаков Е.В.	Основы проектирования топологии ИС:	2010	0,5
	Пантелеев В.И.	учебное пособие. Воронеж: ВГТУ	Печат.	
	9	9.1.2. Дополнительная литература		
9.1.2.1	Быстров Ю.А.	Электронные цепи и микросхемо-	2002	0,4
	Мироненко И.Г.	техника: учеб. пособие - М.: Высш.	Печат.	
	_	шк.		
		9.1.3 Методические разработки		•
9.1.3.1	Строгонов А.В.	Разработка топологических библиотек	2007	1
		КМОП ИС: Методические указания по	Печат.	
		расчетно-конструкторской практике		
		для студентов специальности 210104		
		"Микроэлектроника и твердотельная		
		электроника" очной формы обучения		
		№ 441-2007		
	9.1.4 Про	граммное обеспечение и интернет ресур	СЫ	
9.1.4.1		е видеофрагменты:		
	Технологический ма	ршрут изготовления микросхем		
	Функционально лог	ическое моделирование в САПР		

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

10.1	Учебные лаборатории: 209/4, 212/4		
10.2	Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами и проекторами		
10.3	Натурные лекционные демонстрации: демонстрации изделий электроники и микро-		
	электроники: дискретных приборов, интегральных микросхем.		
10.4	Плакаты и наглядные пособия из фонда кафедры ППЭНЭ		

Карта обеспеченности рекомендуемой литературой дисциплины «Расчетно-конструкторская практика»

No	Авторы,	Заглавие	Год из-	Обеспеченность			
п/п составители			дания.				
			Вид из-				
			дания.				
	1. Основная литература						
Л1.1	Строгонов А.В.	Проектирование устройств цифровой	2013	1			
		обработки сигналов для реализации в	Маг.				
		базисе программируемых логических	носит.				
		интегральных схем: учебное пособие.					
		Воронеж: ВГТУ					
Л1.2	Строгонов А.В	Цифровая обработка сигналов в бази-	2015	1			
	_	се программируемых логических инте-	Маг.				
		ральных схем: учебное пособие. Воро-	носит.				
		неж: ВГТУ					
Л1.3	Бордаков Е.В.	Основы проектирования топологии	2010	0,5			
	Пантелеев В.И.	ИС: учебное пособие. Воронеж: ВГТУ	Печат.				
		2. Дополнительная литература					
Л2.1	Быстров Ю.А.	Электронные цепи и микросхемотех-	2002	0,4			
	Мироненко И.Г.	ника: учеб. пособие - М.: Высш. шк.	Печат.				
Л2.2	Быстров Ю.А.	Электронные цепи и микросхемотех-	2002	0,4			
	Мироненко И.Г.	ника: учеб. пособие - М.: Высш. шк.	Печат.				
	-	3. Методические разработки					
Л3.1	Строгонов А.В.	Разработка топологических библиотек	2007	1			
		КМОП ИС: Методические указания	Печат.				
		по расчетно-конструкторской практи-					
		ке для студентов специальности					
		210104 "Микроэлектроника и твердо-					
		тельная электроника" очной формы					
		обучения № 441-2007					

Зав. кафедрой	/ С.И. Рембеза /		
Директор НТБ	/ Т.И. Буковшина /		

	«УТВЕРЖДАЮ» Председатель Ученого совета факультета радиотехники и электроники		
	Небольсин В.А.		
	(подпись) 201 г.		
Лист регистрации измене Расчетно-конструк			
В УМКД вносятся следующие изменения (допо-			
Изменения (дополнения) в УМКД обсуждены электроники и наноэлектроники	на заседании кафедры полупроводниковой		
Протокол № от «» 20	Γ.		
Зав. кафедрой ППЭНЭ	С.И. Рембеза		
Изменения (дополнения) рассмотрены и одобре	ны методической комиссией ФРТЭ		
Председатель методической комиссии ФРТЭ	А.Г. Москаленко		
«Согласовано»	С.И. Рембеза		

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель Ученого совета факультета радиотехники и электроники

Небольсин В.А.

(подпись)

201 г.

Лист регистрации изменений (дополнений) УМКД

Расчетно-конструкторская практика

В УМКД вносятся следующие изменения (дополнения	я):	
Изменения (дополнения) в УМКД обсуждены на за электроники и наноэлектроники	аседании кафедры	полупроводниковой
Протокол № <u>9</u> от « 16» _ ell 20/6 г.		
Зав. кафедрой ППЭНЭ	Gul	С.И. Рембеза
Изменения (дополнения) рассмотрены и одобрены ме		
Председатель методической комиссии ФРТЭ	lle	А.Г. Москаленко
«Согласовано»	June	С.И. Рембеза

Лист регистрации изменений

	лист регистрации изменении						
Порядко-		Вид изменения (за-	**	Фамилия и инициа-	Дата внесе-		
вый номер	Раздел,	менить, аннулиро-	Номер и дата при-	лы, подпись лица,	ния измене-		
выи помер	пункт	менить, аннулиро-	каза об изменении				
изменения	<i></i>	вать, добавить)		внесшего изменение	кин		